

GaN研究コンソーシアム スプリングスクール開催のご案内

平成30年1月
GaN研究コンソーシアム事務局

GaN研究コンソーシアムは、産学官の共創場での実践的教育を通して、高い専門性と俯瞰的な視点を兼備し、社会のための科学 (Science for Society) を志向する、21世紀型の若手研究者・技術者の育成に努めることにしています。

これを踏まえて、我が国のGaN研究開発の将来を担う優秀な人材を育成するため、昨年に引き続き大学院生、ポストドクター研究員、社会人を対象として、スプリングスクールを開講します。本スクールでは、GaNの結晶成長、デバイスプロセスに関する専門的技術の理解、及びビジネスモデルに関する基礎的知識の修得を目的とした講義、及びグループ研修を通じた交流を行います。

◆開催日 **2018年3月15日(木)・16(金)**

◆場所 **名古屋大学(東山キャンパス) ES総合館1階ES会議室**

(<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>)

◆対象者 **GaN研究コンソーシアムの会員である機関に所属する大学院生、
ポストドクター研究員、社会人**

※会員ではない機関からの参加希望があった場合、会員機関の参加を優先し、定員の範囲内で認めます。

◆募集人数 **50名**

◆募集期間 **2018年2月16日(金)まで**

※応募者が定員に達した場合、募集を締め切ります。
早めにご応募ください。

◆参加費 **《GaN研究コンソーシアムの会員機関》**

各機関2名まで無料。それを超える場合は、一人1万円。

※大学院生は参加費無料、交通費・宿泊費として実費を補助します(最大3万円)

《GaN研究コンソーシアムの会員ではない機関》

一人5万円

◆プログラム **【別紙1】を参照ください。**

スクール長
天野 浩

名古屋大学
未来エレクトロニクス
集積研究センター
教授・センター長

1日目の夕方に
交流会を開催します。
※交流会参加費(別途)
2,000円

参加申し込み方法

下記スクール事務局に、電子メールでご連絡ください。

申し込みの際は、①参加者氏名 ②所属機関 ③職業(学生または役職) ④年齢 ⑤連絡先(電話番号とメールアドレス) ⑥交流会参加の可否 を明記ください。

集合場所・時間等の詳細は参加登録後にメールでご連絡します。

個人情報をお本スクール参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】 GaN研究コンソーシアム/スプリングスクール事務局

E-MAIL: gan-con@aip.nagoya-u.ac.jp (電話 052-747-6584)

【事務局メンバー】名古屋大学

研究協力部社会連携課：加藤 史征

学術研究・産学連携推進本部 企画戦略グループ：佐藤 浩哉、笹岡 千秋、水野 紘一、山口 淳

GaN研究コンソーシアム スプリングスクール プログラム (予定)

【第一日目】 3月15日(木) 専門的技術 (基礎、パワー応用)

(氏名は敬称略)

時 間	内 容	講 師
9:00~9:10	スクール長 挨拶	天野 浩 (名大)
9:10~9:30	オリエンテーション(スケジュール、コース趣旨)	事務局
9:30~11:00	GaN結晶の基礎物性と評価	須田 淳 (名大)
11:00~12:30	GaN結晶成長法とその原理	松本 功 (大陽日酸)
昼 食 (各 自)		
13:30~15:00	GaN電子デバイスの動作原理と特徴	葛原 正明 (福井大)
15:00~16:30	GaNパワーデバイスとその応用	加地 徹 (名大)
17:00~19:00	交流会	

【第二日目】 3月16日(金) 専門的技術 (電子デバイス応用) ビジネスモデル

時 間	内 容	講 師
9:00~10:30	GaN高周波デバイスとその応用	柳生 栄治 (三菱電機)
10:30~12:00	GaN光デバイスとその応用	新田 州吾 (名大)
昼 食 (各 自)		
13:00~14:30	白色LEDが切り拓いた世界	牛田 泰久 (名大)
14:30~16:30	GaN デバイスの社会実装に向けたワークショップ - ”Needs Driven” と ”Back Casting” の 視点から -	深井 昌克 (名大)
16:30~17:00	修了式	